#### 16A/2009S2-008

# 共鳴軟 X 線散乱実験による人工超格子薄膜[(LaMnO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>/(SrMnO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]の研究 Resonant soft x-ray scattering study of [(LaMnO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>/(SrMnO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>] thin film

須田山貴亮<sup>1\*</sup>, 岡本淳<sup>1</sup>, 山崎裕一<sup>1</sup>, 中尾裕則<sup>1</sup>, 村上洋一<sup>1</sup>, 久保田正人<sup>2</sup>, 山田浩之<sup>3</sup>, 澤彰仁<sup>3</sup> <sup>1</sup>KEK 物構研 PF/CMRC、〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 <sup>2</sup>原子力機構、〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4 <sup>3</sup>産総研、〒305-8562 茨城県つくば市東 1-1-1

### 1 <u>はじめに</u>

LaMnO<sub>3</sub>(LMO)と SrMnO<sub>3</sub>(SMO)で作製される超格 子薄膜[(LMO)<sub>m</sub>/(SMO)<sub>n</sub>]において積層枚数である m と n を変化させることで興味深い物性を示すことが 報告されている。特に m = n = 2 (L2S2)では反強磁性 絶縁体(AFI)と強磁性金属(FM)との境界に位置し、 外場を加えることにより巨大な磁気抵抗効果を示す ことが報告されている[1]。これは m = n = 3 (L3S3) でも観測されており、AFI と FM の相競合が原因で あると考えられている。また、この現象は La<sub>1</sub>. <sub>x</sub>Sr<sub>x</sub>MnO<sub>3</sub> バルク試料やその薄膜では観測されておら ず超格子の界面が重要であると考えられている。

加えて、我々は以前、m = n = 5 (L5S5)の積層枚数 の強磁性絶縁体における共鳴軟 X 線散乱実験結果を 報告した。MnのL吸収端( $2p \rightarrow 3d$ )を用い、 [(LaMnO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>/(SrMnO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]をユニットセルとした場合に 散乱ベクトルQ = (00L)の超格子反射のスペクトル を調べた。その結果、L = 1 が強磁性シグナルに対 応した温度変化を示し、L = 2 は顕著な温度変化を しないことを示した[2]。本研究では、電気抵抗でク ロスオーバー的な振る舞いを示すm = n = 3 (L3S3)の 積層枚数を持つ薄膜について共鳴軟 X 線散乱実験を 行い磁性についての研究を行った。

## 2 <u>実験</u>

高エネルギー加速器研究機構のフォトンファクトリーBL-16Aで人工超格子Mn薄膜[(LMO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>/(SMO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]について共鳴軟X線散乱実験を行った。およそ30 Kから260 Kまでの温度変化を測定した。

## 3 結果および考察

図 1 (a)は[(LaMnO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>/(SrMnO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]をユニットセルと した場合に Q = (0 0 L)における Mn の L吸収端付近 の共鳴散乱スペクトルである。測定温度は 40K で行 った。図 1(b)は 1(a)で得られたエネルギースペクト ルから特徴的なピークである L = 1 で見られる peak A と L = 2 で見られる peak B の強度の温度変化であ る。Mn の吸収端で Q = (0 0 L)における L = 1、L = 2 においてそれぞれ異なる温度変化を示す反射のシグ ナルを検出することが出来た。L = 1 では L5S5 と同 様に磁化測定で得られる強磁性転移を示す温度付近 (約 200 K)からシグナルが低温に向けて増大するの に対して、界面の情報を含む L = 2 の反射ではおよ そ 150 K 付近から低温になるにつれてシグナルが増 大する振る舞いを観測した。L = 2 でのこの振る舞



図1: (a) Q = (00L)におけるL = 1,2のMn吸収端 での共鳴散乱スペクトル、(b) Q = (001)で見られる Peak A と(002)で見られる peak B の強度の温度変化

いは L5S5 のときでは見られないものであり、L3S3 の電気抵抗率測定で見られる特徴的なクロスオーバーに関連した磁気成分の振る舞いではないかと考えられる。

今後の研究課題として、磁気抵抗効果を解明する 上で、磁場下での共鳴軟 X 散乱実験を行うことが必 要である。

#### 参考文献

- [1] H. Yamada et al., PRB 81 (2010) 014410.
- [2] M. Kubota et al., 日本物理学会 第 67 回年次大会 25aPS-42
- \* Takaaki.sudayama@kek.jp